



13001 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：D083AJ-00

芯片厚度：240±20μm

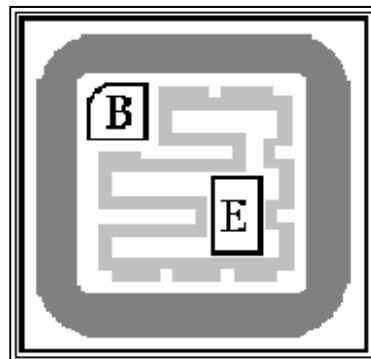
管芯尺寸：830×830μm²焊位尺寸：B 极 140×144μm²，E 极 180×140μm²

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：KSE13001，HE13001

管芯示意图

极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

T _{stg}	贮存温度	-55~150
T _j	结温	150
P _C	集电极耗散功率	900mW
V _{CBO}	集电极—基极电压	600V
V _{CEO}	集电极—发射极电压	400V
V _{EBO}	发射极—基极电压	9V
I _C	集电极电流（DC）	0.25A

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA，I _B =0
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	600			V	I _C =1mA，I _E =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	I _E =1mA，I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	V _{CB} =500V，I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	V _{EB} =9V，I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	8		70		V _{CE} =10V，I _C =20mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			0.6	V	I _C =100mA，I _B =20mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.2	V	I _C =100mA，I _B =20mA
f _T	特征频率	8			MHz	V _{CE} =10V，I _C =20mA